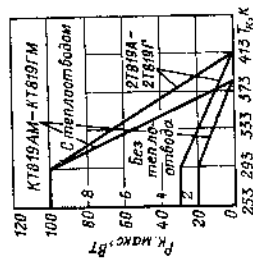


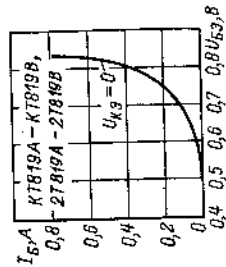
Примечания: 1. Постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода при $T_K = 298 \pm 373$ К снижается линейно на 0,015 Вт через 1 К КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г и на 0,02 Вт через 1 К КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ.

2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.

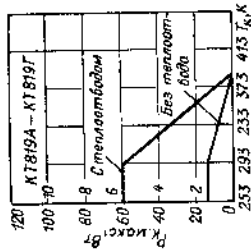
При монтаже в схему транзисторов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г допускается оторазовый изгиб выводов на расстоянии не менее 2,5 мм от корпуса под углом 90° , радиусом не менее 0,8 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.



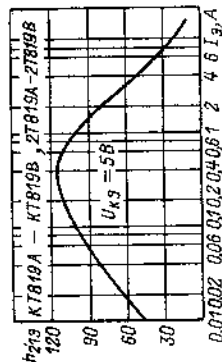
Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.



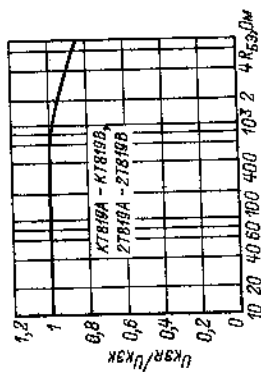
Входная характеристика.



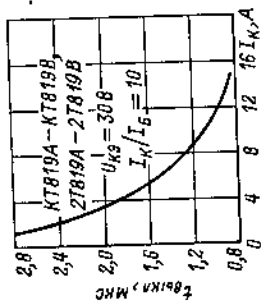
Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



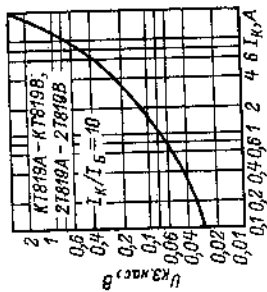
Зависимость напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.



Зависимость времени выключения от тока коллектора.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса.

Зависимость граничного напряжения от температуры корпуса.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



КТ821А-1, КТ821Б-1, КТ821В-1

Транзисторы кремневые меза-эпитаксиально-планарные $n-p-n$ универсальные низкочастотные мощные.